

КТ634Б-2
кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
n-p-n транзистор

Назначение

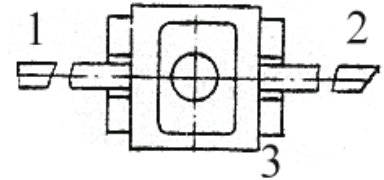
Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n СВЧ транзистор КТ634Б-2, предназначенный для применения в аппаратуре связи, а также другой радиоэлектронной аппаратуре.

Обозначение технических условий

- аАО.336.291 ТУ

Корпусное исполнение

- бескорпусное исполнение



Маркировка

- две красные точки

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ634Б-2 при $T_{окр. среды} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мА	$U_{кб}=30В$		1
Емкость коллекторного перехода*	$C_{к*}$	пФ	$U_{кб}=15В$ $f=10МГц$		3
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером	$F_{гр*}$	МГц	$U_{кз}=10В$ $f=300МГц$ $I_{к}=100мА$	1500	
Обратный ток эмиттера	$I_{эбо}$	мА	$U_{эб}=3 В$		0,2

* справочные параметры

Таблица 2. Предельно-допустимые режимы эксплуатации КТ634Б-2 при $T_{окр. среды} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Значение
Напряжение коллектор-база	$U_{св max}$	В	30
Напряжение эмиттер-база	$U_{ев max}$	В	3
Постоянный ток коллектора	$I_{с max}$	А	0,15
Постоянный ток базы	$I_{в max}$	мА	75
Температура перехода	T_j	$^\circ C$	150
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	$P_{с max}$	Вт	1,2

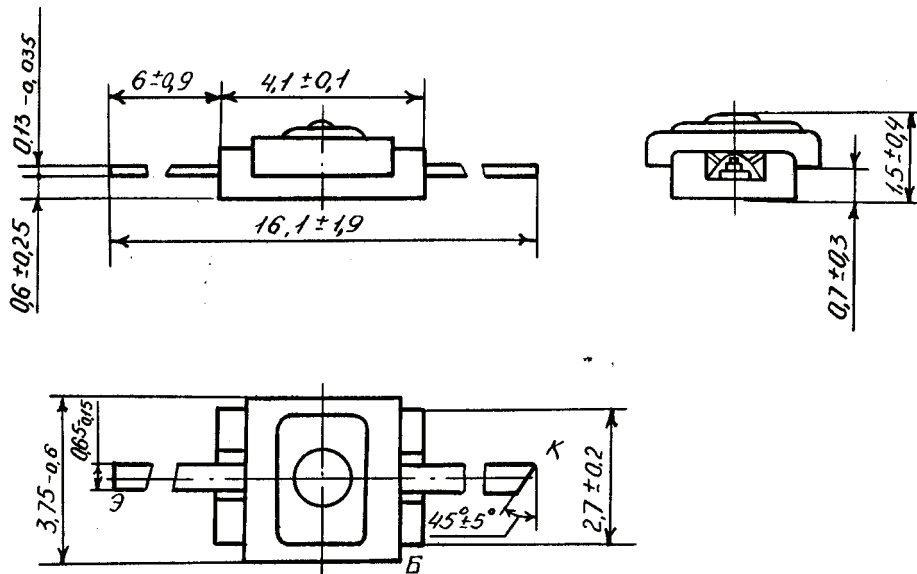


Рисунок 1. Габаритный чертеж КТ634Б-2